

- [3] Климин В.Ф. // ЖТФ. 1986. Т. 56. Вып. 10. С. 2041–2043.  
[4] Мик Дж. Крэгс Дж. Электрический пробой в газах. М.: ИЛ, 1960. 605 с.  
[5] Авроров А.П., Воробьев В.Г. Препринт ИЯФ СО АН СССР. № 83–69. Новосибирск, 1983. 32 с.

Новосибирский университет

Поступило в Редакцию  
14 сентября 1991 г.

01:10  
© 1992 г.

Журнал технической физики, т. 62, в. 9, 1992

## АКСЕПТАНС КВАДРУПОЛЬНОГО ФИЛЬТРА МАСС В РЕЖИМЕ РАБОТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗОНЫ СТАБИЛЬНОСТИ

Н.В. Коненков, Г.А. Могильченко,  
С.С. Силаков

1. С целью оптимизации согласования источника ионов и квадрупольного фильтра масс (КФМ) необходимо знание аксептанса анализатора. Аксептанс КФМ характеризуют областями пропускания на фазовой плоскости поперечных координат и скоростей влета ионов в анализатор [1,2]. Если для обычного режима аксептанс исследован достаточно полно [1–7], то для режима работы в четырехугольнике стабильности — промежуточной зоны [8] такие данные отсутствуют. Поэтому целью работы на первом этапе является исследование аксептанса идеального фильтра масс.

2. Под идеальным квадрупольным фильтром масс понимается анализатор, у которого отсутствуют краевые поля, распределение потенциала гиперболическое, время сепарации ионов велико. В этом случае аксептанс КФМ в динамике описывается эллипсами захвата вида [2]

$$\Gamma u^2 + 2Au\dot{u} + B\dot{u}^2 = \varepsilon = r_0^2/B \max, \quad (1)$$

где  $\varepsilon$  называют аксептансом, величина которого численно равна площади эллипса, деленного на  $\pi$ ;  $A$ ,  $B$ ,  $\Gamma$  — параметры, зависящие от положения рабочей точки  $a$ ,  $q$  на диаграмме стабильности и от фазы  $\xi_0 = \omega t_0/2$  влета иона в анализатор; круговая частота ВЧ поля; через  $u$ ,  $\dot{u}$  обозначены поперечные координаты ( $x$  или  $y$ ) и соответствующие скорости.

В динамике эллипсы врачаются с частотой  $\omega$  ВЧ поля и определяют области допустимых значений начальных поперечных координат и скоростей, при которых амплитуда колебаний ионов будет меньше апертуры анализатора  $r_0$ , равной радиусу вписанной окружности между вершинами электродов,  $B \max$  — максимальное значение параметра  $B$ .

3. Контур 100%-го пропускания на фазовой плоскости  $u$ ,  $\dot{u}$  определяется как граница области допускаемых начальных значений  $\{u, \dot{u}\}$ , при которых вероятность пропускания идеального анализатора равна единице. Этот контур можно построить по границам эллипсов при различных начальных фазах наложением их друг на друга [1]. Таким способом

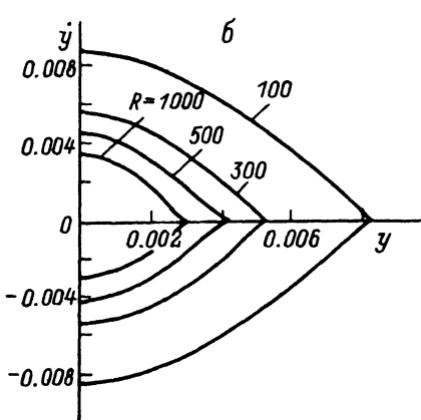
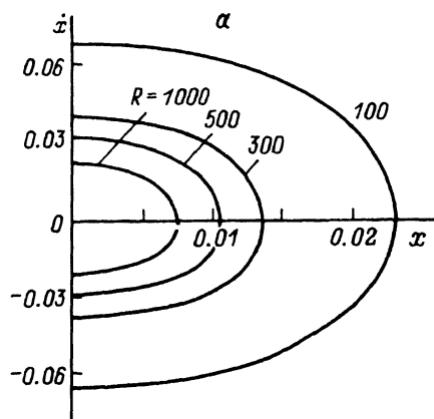


Рис. 1. Контуры 100%-го пропускания в рабочей области стабильности вблизи вершины  $M$   
 $a$  —  $x$ ,  $x$ -плоскость;  $b$  —  $y$ ,  $y$ -плоскость.

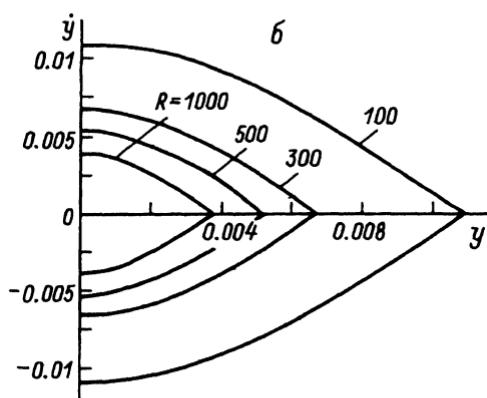
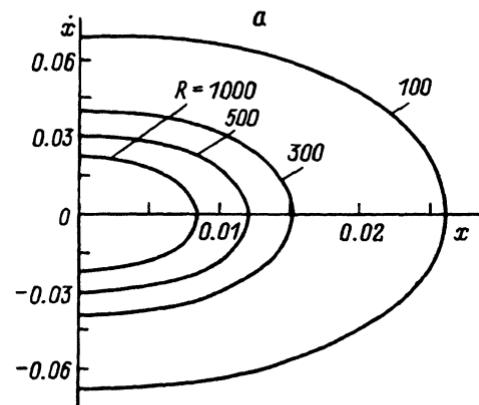


Рис. 2. Контуры 100%-го пропускания вблизи нижней вершины  $S$  при различных значениях разрешающей способности  $R$ .  
 $a$  — фазовая плоскость  $x$ ,  $\dot{x}$  начальных условий,  $b$  —  $y$ ,  $\dot{y}$ -плоскость.

построены контуры 100%-го пропускания для рабочих областей промежуточной зоны вблизи вершины  $M$  (рис. 1) и вершины  $S$  (рис. 2) по 20 эллипсам для  $x$ ,  $\dot{x}$ - и  $y$ ,  $\dot{y}$ -фазовых плоскостей. Контуры приведены для различных значений разрешающей способности  $R$  в рабочих точках  $a$  и  $q$  [8]:

$$M : \quad q = 3.23408; \quad a = 3.16429 - 1/R; \quad (2)$$

$$S : \quad q = 2.8153; \quad a = 2.5210 + 0.9374/R. \quad (3)$$

Как следует из рис. 1 и 2, акцептанс по  $x$ -координате на порядок пре-восходит акцептанс по  $y$ -координате как вблизи верхней вершины  $M$ , так и нижней  $S$ . Форма контура для  $y$ ,  $\dot{y}$ -плоскости соответствует форме такого же контура обычного режима [3], а для  $x$ ,  $\dot{x}$ -плоскости незначительно отличается. Это связано с тем, что промежуточная зона представляет

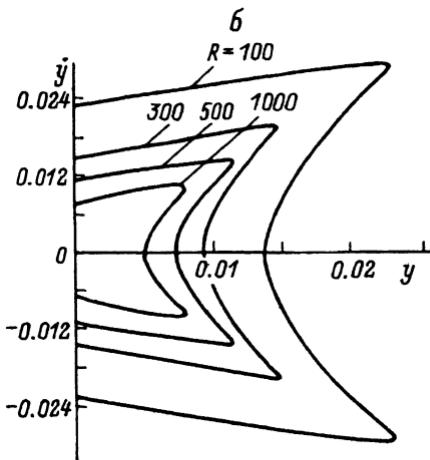
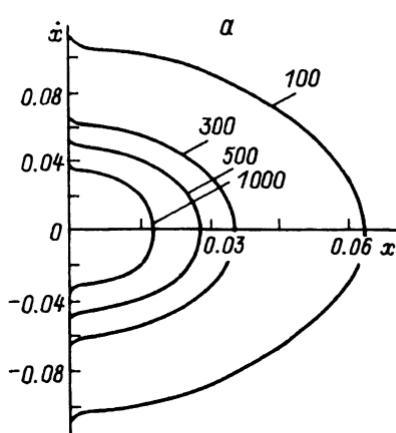


Рис. 3. Контуры 50%-го пропускания. Вершина  $M$ .  
а, б — то же, что и на рис. 2.

собой "смесь" ионно-оптических свойств первой и второй областей стабильности [8].

Из данных рис. 1 и 2 следует, что несоосность источника ионов и анализатора со смещением  $\Delta r \gtrsim 0.02r_0$  при  $R = 1000$  приводит к катастрофической потере выходного сигнала.

4. Контур 50%-го пропускания определяется совокупностью точек  $u$ ,  $\dot{u}$ , при которых вероятность прохождения ионами бесконечно длинного анализатора равна 0.5. Контуры 50%-го пропускания (рис. 3, 4) находились методом, изложенным кратко в работе [7]. Производился расчет параметров 100 эллипсов захвата и далее находилась совокупность точек  $\{u, \dot{u}\}$ , для которых 50 значений начальных фаз удовлетворяют условию  $\Gamma u^2 + 2Au\dot{u} + B\dot{u}^2 < \varepsilon$ . При решении уравнения Маттье, описывающего движение ионов, использовался матричный метод дискретностью времени  $\Delta\xi = \pi/1000$  и интервалом начальных фаз  $\Delta\xi_0 = \pi/100$ .

Форма контуров 50%-го пропускания для  $x$  и  $y$ -траекторий ионов (рис. 3, 4) аналогична обычному режиму [3]. Отметим также, что акцептанс КФМ по  $x$ -координате выше, чем в первой области стабильности. Так, при разрешающей способности  $R = 55$  в обычном режиме при параллельном вводе ионов относительно оси КФМ ( $\dot{u} = 0$ )  $x_{50\%} \simeq 0.045r_0$ ,  $y_{50\%} \simeq 0.05r_0$  [3], в то время как для  $S$ -вершины (рис. 4)  $x_{50\%} \simeq 0.1r_0$ ,  $y_{50\%} \simeq 0.09r_0$  при разрешающей способности  $R = 100$ .

5. На рис. 5 представлены зависимости акцептансов, определенных по 100- и 50%-ным уровням пропускания КФМ, от разрешающей способности  $R$ . Приблизительно акцептанс (площадь, ограниченная контуром) с ростом разрешающей способности убывает по закону  $\varepsilon \sim R^{-1}$ . Акцептанс КФМ выше в области вершины  $S$ , чем в области верхней вершины  $M$  промежуточной области. При этом акцептанс по  $y$ -координате на порядок меньше, чем по  $x$ -координате. Из представленных данных на рис. 5 можно сделать вывод, что пропускание КФМ в промежуточной области определяется  $x$ -акцептансом. Это также подтверждается расчетами плотности распределения ионов [9], которые показывают, что выходной пучок ионов

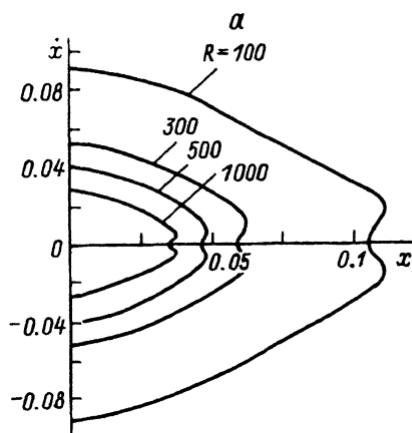


Рис. 4.а.

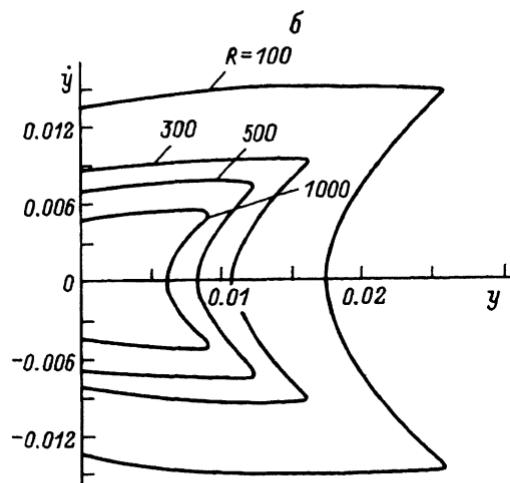


Рис. 4. Контуры 50%-го пропускания.  
Вершина  $S$ .  
 $a, b$  — то же, что и на рис. 2.

в сечении вытянут вдоль  $x$ -координаты. Ось  $x$  проходит через вершины электродов анализатора, на которые подают положительный потенциал при анализе положительных ионов. Для первой области распределение ионов по сечению пучка вытянуто вдоль  $y$ -электродов [10], т.е. можно сказать, что пропускание КФМ в этом случае в основном определяется  $y$ -акцептантом. По этой причине для первой области являются более критичными положение  $y$ -электродов анализатора, уход питающих напряжений на  $y$ -электродах от номинала. Для четырехугольника стабильности указанное справедливо для  $x$ -электродов, что подтверждается экспериментально [11].

6. Первые эксперименты [12,13] по исследованию режима сепарации в четырехугольнике стабильности — промежуточной зоны обнаружили относительно слабое проявление краевых полей. Дело в том, что при линейном нарастании потенциала в краевой области ионы движутся вне зоны стабильности и это должно приводить их к потерям. Возможно, что эти потери невелики из-за того, что время пребывания ионов в краевой

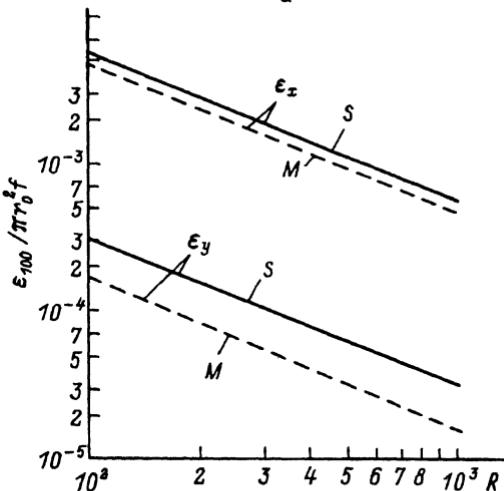
*a*

Рис. 5.а.

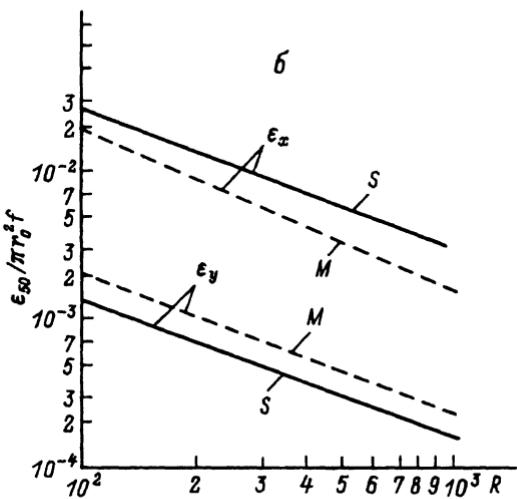
*b*

Рис. 5. Зависимости аксептанса КФМ от разрешающей способности.

а — 100%-ное пропускание; б — 50%-ное пропускание.

области мало (0.3–1 период ВЧ поля). Тем не менее для получения детальной картины потерь ионов необходимо исследование аксептанса реального КФМ. Поэтому вторым этапом исследования аксептанса КФМ являются учет и анализ влияния краевых полей.

#### Список литературы

- [1] Dawson P.H. // Int. J. Mass Spectr. Ion Phys. 1975. Vol. 17. P. 423–445.
- [2] Dawson P.H. Quadrupole Mass-spectrometry and its Applications. Amsterdam: Elsevier, 1976. 249 р.
- [3] Dawson P.H. // Int. J. Mass Spectr. Ion Process. 1990. Vol. 100. P. 41–50.
- [4] Усачева Т.В., Ермаков М.С. Научное приборостроение. Приборы и средства автоматизации для научных исследований. Л., 1987. С. 33–39.
- [5] Матанцев А.И., Титов В.В. // ВАНТ. Сер.РТ. 1986. № 1 (32). С. 74–78.

- [6] Hunter K.L., McIntosh B.J. // Int. J. Mass Spectr. Ion Process. 1989. Vol. 87. P. 157-164.  
 [7] McIntosh B.J., Hunter K.L. // Int. J. Mass Spectr. Ion Process. 1989. Vol. 87. P. 165-179.  
 [8] Konenkov N.V., Kratenko V.I. / Int. J. Mass Spectr. Ion Process. 1991. Vol. 108. P. 115-136.  
 [9] Коненков Н.В., Силаков С.С. // ЖТФ. 1991. Т. 61. Вып. 3. С. 145-146.  
 [10] Todd F.G., Waldren P.M., Freer D.A., Turner R.B. // Int. J. Mass Spectr. Ion Phys. 1980. Vol. 35. P. 107-150.  
 [11] Коненков Н.В., Кратенко В.И., Могильченко Г.А., Силаков С.С. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. Вып. 15. С. 23-27.  
 [12] Коненков Н.В., Силаков С.С., Могильченко Г.А. и др. // ЖТФ. 1990. Т. 60. Вып. 1. С. 117-122.  
 [13] Коненков Н.В., Могильченко Г.А., Силаков С.С. // ЖТФ. 1990. Т. 60. Вып. 6. С. 128-132.

Научно-исследовательский  
технологический институт  
Рязань

Поступило в Редакцию  
23 сентября 1991 г.

09;12  
© 1992 г.

Журнал технической физики, т. 62, в. 9, 1992

## К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ СМЕЩЕНИЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ КОМПОЗИЦИОННОГО ФЕРРИТ-ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА

B.M. Лалетин

Известно, что под действием магнитного поля в резонаторах, изготовленных из композиционной керамики феррит-пьезоэлектрик, наблюдается смещение резонансной частоты [1,2]. В настоящее время существует два механизма, объясняющие это явление: 1) магнитное поле → деформация магнитной фазы → деформация пьезоэлектрической фазы → изменение упругих свойств пьезоэлектрической фазы → изменение упругих свойств композиционного материала → смещение резонансной частоты, 2) магнитное поле → деформация магнитной фазы → изменение упругих свойств магнитной фазы → изменение упругих свойств композиционного материала → смещение резонансной частоты.

Как видно из приведенных схем, смещение частоты определяется в первом случае изменением упругих свойств пьезоэлектрической фазы, во втором — изменением упругих свойств магнитной фазы. Необходимо отметить, что оба эти механизма реальны, поэтому нельзя отрицать существование какого-либо из них.

В работе [2], исходя из качественного совпадения характера смещения частоты в резонаторах, изготовленных из композиционной керамики, и поведения модуля Юнга чистых ферритов в магнитных полях, делается заключение, что смещение частоты происходит вследствие изменения упругих свойств ферритовой фазы ( $\Delta E$ -эффект). Но такого вывода, основывающегося на аналогиях, недостаточно для строгого утверждения.

В связи с этим представляет интерес экспериментально оценить вклад каждого механизма в наблюдаемое явление. С этой целью был проведен